ハ　インプリントリソグラフィテンプレートであって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの又はその部分品若しくは附属品

ニ　極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したマスク又はレチクルであって、次号に該当するマスクブランクを有するもの又はこれらの部分品若しくは附属品（ホに掲げるものを除く。）

ホ　ペリクルであって、極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したもの

十七の四　（略）

（削る）

十八　基板であって、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質の多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの（次号に該当するもの又は二に該当する化合物（窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。）のＰ型エピタキシャル層を一層以上有するものであって、当該Ｐ型エピタキシャル層がＮ型層に挟まれていないものを除く。）

イ～ヘ　（略）

十八の二　基板であって、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質の一層以上からなる膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、エピタキシャル材料となるもの

イ　シリコンであって、シリコン二八又はシリコン三〇以外のシリコンの同位体からなる不純物の割合が〇・〇八パーセント未満のもの

ロ　ゲルマニウムであって、ゲルマニウム七〇、ゲルマニウム七二、ゲルマニウム七四又はゲルマニウム七六以外のゲルマニウムの同位体からなる不純物の割合が〇・〇八パーセント未満のもの

十九～二十四　（略）

十七の三　（略）

十七の四　半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した走査型電子顕微鏡であって、次のイからトまでの全てに該当するもの（国際半導体製造装置材料協会が定めたＳＥＭＩ規格に準拠したウエハーの搬送・保管容器（二〇〇ミリメートル以上のフロント・オープニング・ユニファイド・ポッド（ＦＯＵＰ）を含む。）用にウエハー搬入部を設計したものを除く。）

イ　ステージの位置決め精度が三〇ナノメートル未満のもの

ロ　レーザー干渉計によるステージ位置計測が可能なもの

ハ　レーザー干渉計による長さスケール計測に基づく視野の位置校正が可能なもの

ニ　画素数が二〇〇、〇〇〇、〇〇〇を超える画像の収集及び保存が可能なもの

ホ　画像を取得する際の視野の重なりが垂直方向及び水平方向で五パーセント未満のもの

ヘ　画像を結合する際の視野の重なりが五〇ナノメートル未満のもの

ト　加速電圧が二一キロボルトを超えるもの

十八　基板であって、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質の多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの（二に該当する化合物（窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。）のＰ型エピタキシャル層を一層以上有するものであって、当該Ｐ型エピタキシャル層がＮ型層に挟まれていないものを除く。）

イ～ヘ　（略）

（新設）

十九～二十四　（略）